Catálogo de produtos

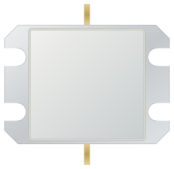
# Transistores de potência RF

Transistores de potência RF convertem polarização e excitação RF em potência de saída dentro de um estágio amplificador. Eles aparecem em cadeias de transmissão, módulos pulsados ou contínuos, equipamentos RF industriais e bancadas de teste de alta potência.



Produtos: 11

Revisão: 9 · Data da revisão: 2026-11-11



## LCT-5700-7100-PS51T

**5700–7100 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 51 dBm (típico)**

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (típico); Ganho de potência 11 dB (típico); PAE 45 % (típico).

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 5700; Máximo: 7100; Valor: 5700–7100; Unidade: MHz

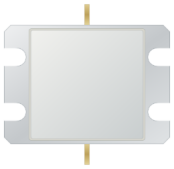
**Potência de saída saturada:** Mínimo: 50.5; Típico: 51; Unidade: dBm

**Ganho de potência:** Mínimo: 10.5; Típico: 11; Unidade: dB

**Eficiência de potência adicionada:** Mínimo: 40; Típico: 45; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-2700-3500-PS56p5T

**2700–3500 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 56.5 dBm (típico)**

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (típico); Ganho de potência 13.5 dB (típico); PAE 55 % (típico).

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

**Potência de saída saturada:** Mínimo: 56; Típico: 56.5; Unidade: dBm

**Ganho de potência:** Mínimo: 13; Típico: 13.5; Unidade: dB

**Eficiência de potência adicionada:** Mínimo: 50; Típico: 55; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-5300-5900-PS56p5T

**5300–5900 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 56.5 dBm (típico)**

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (típico); Ganho de potência 12.5 dB (típico); PAE 45 % (típico).

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 5300; Máximo: 5900; Valor: 5300–5900; Unidade: MHz

**Potência de saída saturada:** Mínimo: 56; Típico: 56.5; Unidade: dBm

**Ganho de potência:** Mínimo: 12; Típico: 12.5; Unidade: dB

**Eficiência de potência adicionada:** Mínimo: 40; Típico: 45; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-2700-3900-PS48p5T

**2700–3900 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 48.5 dBm (típico)**

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (típico); Ganho de potência 12.5 dB (típico); PAE 50 % (típico).

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidade: MHz

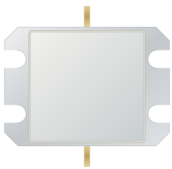
**Potência de saída saturada:** Mínimo: 48; Típico: 48.5; Unidade: dBm

**Ganho de potência:** Mínimo: 12; Típico: 12.5; Unidade: dB

**Eficiência de potência adicionada:** Mínimo: 45; Típico: 50; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-2700-3500-PS53p5T

**2700–3500 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 53.5 dBm (típico)**

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (típico); Ganho de potência 13.5 dB (típico); PAE 65 % (típico).

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

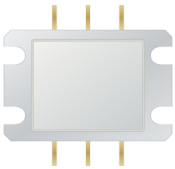
**Potência de saída saturada:** Mínimo: 53; Típico: 53.5; Unidade: dBm

**Ganho de potência:** Mínimo: 13; Típico: 13.5; Unidade: dB

**Eficiência de potência adicionada:** Mínimo: 60; Típico: 65; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-2300-3900-PS50T

**2300–3900 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 50 dBm (típico)**

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (típico); Ganho de potência 12 dB (típico); PAE 50 % (típico).

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 2300; Máximo: 3900; Valor: 2300–3900; Unidade: MHz

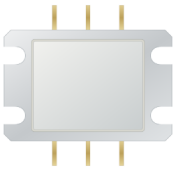
**Potência de saída saturada:** Mínimo: 49; Típico: 50; Unidade: dBm

**Ganho de potência:** Mínimo: 11; Típico: 12; Unidade: dB

**Eficiência de potência adicionada:** Mínimo: 45; Típico: 50; Unidade: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-2600-3700-PS49T

**2600–3700 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 49 dBm (típico)**

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (típico); Ganho de potência 13 dB (típico); PAE 50 % (típico).

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 2600; Máximo: 3700; Valor: 2600–3700; Unidade: MHz

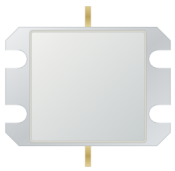
**Potência de saída saturada:** Mínimo: 48; Típico: 49; Unidade: dBm

**Ganho de potência:** Mínimo: 12; Típico: 13; Unidade: dB

**Eficiência de potência adicionada:** Mínimo: 45; Típico: 50; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-8500-9600-PS51T

**8500–9600 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 51 dBm (típico)**

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (típico); Ganho de potência 9 dB (típico); PAE 38 % (típico).

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 9600; Valor: 8500–9600; Unidade: MHz

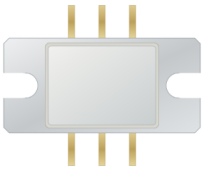
**Potência de saída saturada:** Mínimo: 50; Típico: 51; Unidade: dBm

**Ganho de potência:** Mínimo: 8; Típico: 9; Unidade: dB

**Eficiência de potência adicionada:** Típico: 38; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-2000-6000-PO45p51T

### 2000–6000 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (típico)

2000–6000 MHz; Potência de saída de referência 45.51 dBm (típico); Ganho de potência 19.51 dB (típico); Eficiência de dreno 39.82 % (típico) @ 6000 MHz.

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

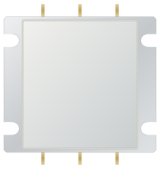
**Potência de saída de referência:** Típico: 45.51; Unidade: dBm; Notas: f = 6000 MHz

**Ganho de potência:** Típico: 19.51; Unidade: dB; Notas: f = 6000 MHz

**Eficiência de dreno:** Símbolo: ηD; Típico: 39.82; Unidade: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-700-6200-PS49T

### 700–6200 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (típico)

700–6200 MHz; Potência de saída saturada 49 dBm (típico); Ganho de potência 7 dB (típico); Eficiência de dreno 35 % (típico) @ 6000 MHz.

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 700; Máximo: 6200; Valor: 700–6200; Unidade: MHz

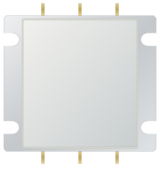
**Potência de saída saturada:** Símbolo: Psat; Típico: 49; Unidade: dBm; Notas: f = 6000 MHz

**Ganho de potência:** Típico: 7; Unidade: dB; Notas: f = 6000 MHz

**Eficiência de dreno:** Símbolo: ηD; Típico: 35; Unidade: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto



## LCT-2000-6200-PO50p1T

### 2000–6200 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (típico)

2000–6200 MHz; Potência de saída de referência 50.1 dBm (típico); Ganho de potência 8.6 dB (típico); Eficiência de dreno 52.4 % (típico) @ 6000 MHz.

**Frequência de operação:** Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6200; Valor: 2000–6200; Unidade: MHz

**Potência de saída de referência:** Típico: 50.1; Unidade: dBm; Notas: f = 6000 MHz

**Ganho de potência:** Típico: 8.6; Unidade: dB; Notas: f = 6000 MHz

**Eficiência de dreno:** Símbolo: ηD; Típico: 52.4; Unidade: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Detalhes do produto  Ficha técnica do produto

**Aviso do documento**

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.